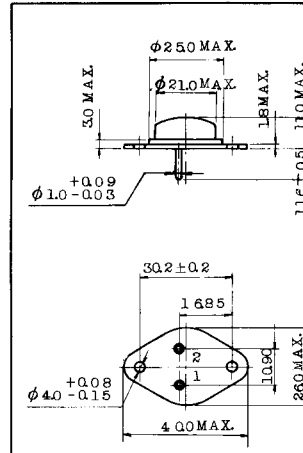


シリコンPNP三重拡散メサ形トランジスタ  
 SILICON PNP TRIPLE DIFFUSED MESA TRANSISTOR

2SB557

Unit in mm

- 電力増幅用
- Power Amplifier Applications
- ・ コレクタ損失が大きい ;  $P_C = 80W$
- ・ 高耐圧です ;  $V_{CEO} = -120V$
- ・ 2SD427 とコンプリメンタリになります。
- ・ 50W Hi-Fi オーディオアンプ出力段に最適です。
- ・ Complementary to 2SD427
- ・ Recommended for 50W High-Fidelity Audio Frequency Amplifier Output Stage



1. BASE  
 2. EMITTER  
 COLLECTOR (CASE)

JEDEC TO-3

EIAJ TC-3, TB-3

TOSHIBA 2-21A1A

最大定格 MAXIMUM RATINGS (  $T_a = 25^\circ C$  )

CHARACTERISTIC	SYMBOL	RATING	UNIT
コレクタ・ベース間電圧	$V_{CB0}$	-120	V
コレクタ・エミッタ間電圧	$V_{CEO}$	-120	V
エミッタ・ベース間電圧	$V_{EB0}$	- 5	V
コレクタ電流	$I_C$	- 8	A
エミッタ電流	$I_E$	8	A
コレクタ損失	$P_C$	80	W
接合温度	$T_j$	150	$^\circ C$
保存温度	$T_{S t g}$	-65 ~ 150	$^\circ C$

アクセサリは AC 73 を使用  
 MOUNTING KIT 番 AC 73

# 2SB557

電気的特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS (  $T_a = 25^\circ\text{C}$  )

CHARACTERISTIC	SYMBOL	CONDITION	MIN.	TYP.	MAX.	UNIT
コレクタしや断電流	$I_{CBO}$	$V_{CB} = -60\text{V}, I_E = 0$	—	—	-100	$\mu\text{A}$
エミッタしや断電流	$I_{EBO}$	$V_{EB} = -5\text{V}, I_C = 0$	—	—	-100	$\mu\text{A}$
コレクタ・エミッタ間降伏電圧	$V_{(BR)CEO}$	$I_C = -0.1\text{A}, I_B = 0$	-120	—	—	V
エミッタ・ベース間降伏電圧	$V_{(BR)EBO}$	$I_E = -10\text{mA}, I_C = 0$	-5	—	—	V
直流電流増幅率	$h_{FE(1)}$ (Note)	$V_{CE} = -5\text{V}, I_C = -1\text{A}$	40	—	140	
	$h_{FE(2)}$	$V_{CE} = -5\text{V}, I_C = -5\text{A}$	20	—	—	
コレクタ・エミッタ間飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	$I_C = -5\text{A}, I_B = -0.5\text{A}$	—	—	-2.5	V
ベース・エミッタ間電圧	$V_{BE}$	$V_{CE} = -5\text{V}, I_C = -5\text{A}$	—	—	-2.0	V
トランジション周波数	$f_T$	$V_{CE} = -5\text{V}, I_E = 1\text{A}$	—	7	—	MHz
コレクタ出力容量	$C_{ob}$	$V_{CB} = -10\text{V}, I_E = 0$ $f = 1\text{MHz}$	—	280	—	pF

Note ;  $h_{FE(1)}$  により下表のように分類し、現品表示してあります。

According to the value of  $h_{FE(1)}$ , the 2SB557 is classified as follows.

CLASSIFICATION	MIN.	MAX.
2SB557-R	40	80
2SB557-O	70	140